

МОДУЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СИЛОВЫЕ С ТРЁХФАЗНОЙ МОСТОВОЙ СХЕМОЙ M02/13



Общие сведения

Модули полупроводниковые силовые с мостовой схемой M02/10 с беспотенциальным основанием, состоят из силовых полупроводниковых диодных структур, соединенных по трёхфазной мостовой схеме. Модули предназначены для преобразования переменного тока в постоянный в различных силовых электротехнических установках частотой до 500 Гц.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения У2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150.

Модули предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях исключающих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, гамма - излучения).

Модули допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением 50 м/с² и одиночных ударов длительностью импульса 50 мс и ускорением 40 м/с². Группа M27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.

Рекомендуемые охладители ОР234-60, ОР234-80 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004.

Модули по своим параметрам и характеристикам соответствуют ТУ У 32.1-30077685-016-2004.

Структура условного обозначения модуля

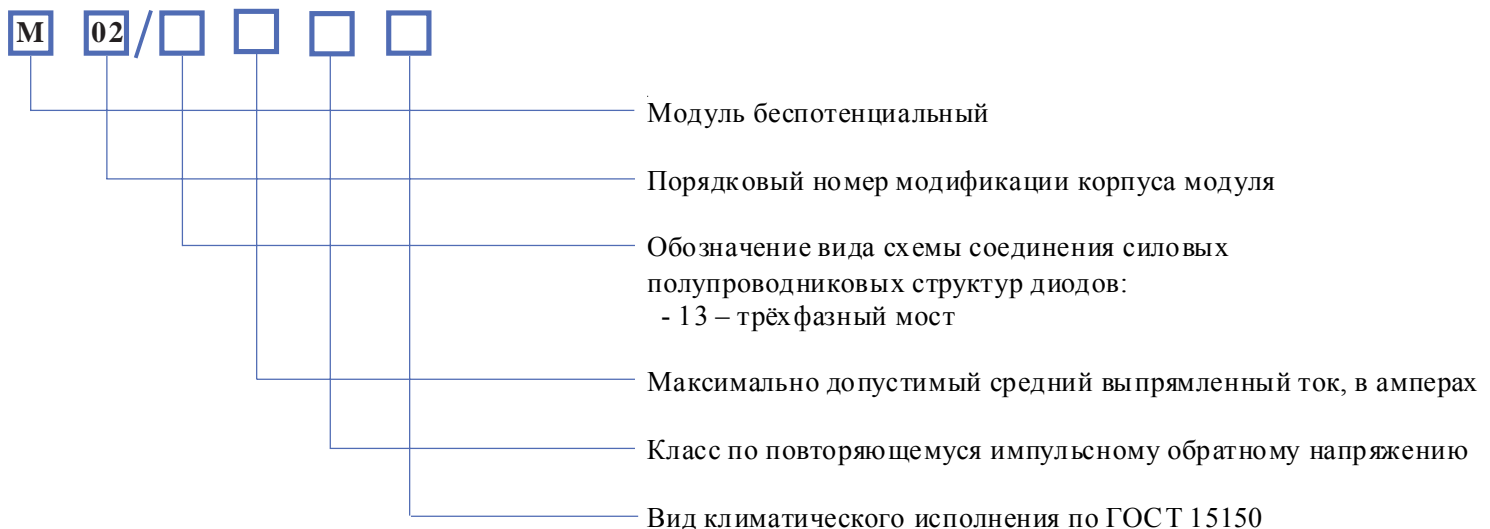
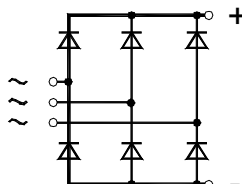


Схема внутреннего соединения диодных структур в модулях



Комплектность поставки и формулирование заказа

Модули поставляются без охладителей, но по согласованию с предприятием-изготовителем могут поставляться с охладителем и комплектом крепежных деталей.

К каждой партии модулей, транспортируемых в один адрес, прилагается этикетка.

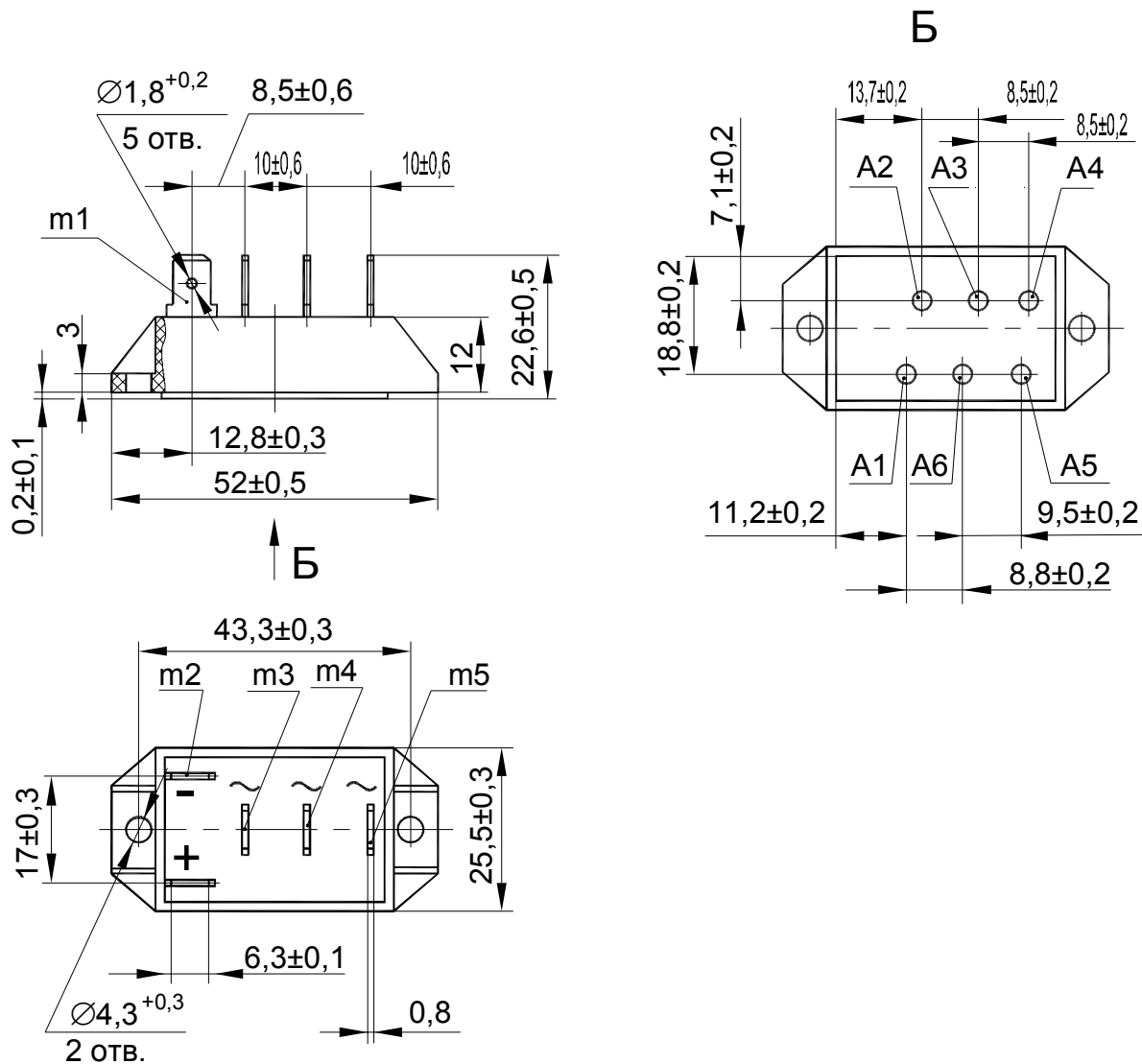
При заказе модулей необходимо указать:

тип, класс, комплектность поставки, количество, номер технических условий.

Пример заказа 100 штук модулей типа M02/13-50 двенадцатого класса.

M02/13-50-12 ТУ У 32.1-30077685-016-2004 100 шт., без охладителей

Габаритно-присоединительные размеры модулей



A1, A2, A3, A4, A5, A6 - области контроля температуры корпуса модуля $\varnothing 3$ мм;
m1, m2, m3, m4, m5 - контрольные точки измерения импульсного прямого напряжения
(в любом месте на поверхности вывода)

Обратные параметры

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	MO2/13-16 MO2/13-25 MO2/13-32 MO2/13-40 MO2/13-50	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение *, В, для классов:	1	$T_{jm} = 125^{\circ}C$. Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс.
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		U_{RRM}	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
U_{RWM}	Рабочее импульсное обратное напряжение *, В		$0,8U_{RRM}$
U_R	Постоянное обратное напряжение *, В	$0,6U_{RRM}$	$T_c = 85^{\circ}C$
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток *, мА, не более	1,2	$T_{jm} = 25^{\circ}C$
		2,5	$T_{jm} = 125^{\circ}C$

*Значения норм параметров приведены для одной диодной структуры, входящей в состав модуля

Прямые параметры

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	МО2/13-16	МО2/13-25	МО2/13-32	МО2/13-40	МО2/13-50	
I_d	Максимально допустимый средний выпрямленный ток, А	16	25	32	40	50	$T_c=85^\circ\text{C}$ Импульсы тока синусоидальные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц.
I_{FSM}	Ударный прямой ток*, А	165	220	330	385	$T_j=25^\circ\text{C}$	
		150	200	300	350	$T_{jm}=125^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс	
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение*, В, не более	1,5	1,4			1,3	$T_j=25^\circ\text{C}$, $I_F=1,046I_d$
U_{TO}	Пороговое напряжение*, В, не более	0,9					$T_{jm}=125^\circ\text{C}$
r_T	Динамическое сопротивление в прямом направлении*, мОм, не более	36	19	15	12	8	$T_{jm}=125^\circ\text{C}$
I_d	Средний выпрямленный ток модуля на охладителе при $T_a=40^\circ\text{C}$, А	естественное охлаждение					
		12	14	15	16	17	охладитель ОР234-80
		10	12	12	13	14	охладитель ОР234-60
		принудительное охлаждение $v=6$ м/с					
		16	25	29	33	37	охладитель ОР234-80

*Значения норм параметров приведены для одной диодной структуры, входящей в состав модуля

Тепловые параметры

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	MO2/13-16	MO2/13-25	MO2/13-32	MO2/13-40	MO2/13-50	
T_{jm}	Максимально допустимая температура перехода, °C	125					
T_{jmin}	Минимально допустимая температура перехода, °C	минус 50					
T_{stgm}	Максимально допустимая температура хранения, °C	40					
T_{stgmin}	Минимально допустимая температура хранения, °C	минус 50					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход-корпус одного элемента, °C/Вт, не более	3,6	3,0	2,4	1,8	1,56	Постоянный ток
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Вт, не более	0,45					
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход-среда одного элемента, °C/Вт, не более	естественное охлаждение					
		16,65	16,05	15,45	14,85	14,61	охладитель OP234-80
		20,85	20,25	19,65	19,05	18,81	охладитель OP234-60
		принудительное охлаждение, $v=6$ м/с					
		8,07	7,47	6,87	6,27	6,03	охладитель OP234-80

Параметры гальванической развязки

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	MO2/13-16 MO2/13-25 MO2/13-32 MO2/13-40 MO2/13-50	
U_{isol}	Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным основанием модуля и его выводами, В (действующее значение)	2000 (для 1-8 кл.) 2500 (для 9-12 кл.)	Нормальные климатические условия. Частота испытательного напряжения 50 Гц. Время приложения испытательного напряжения не менее 60 с.
		1500	Повышенная влажность (100% при 25°C). Частота испытательного напряжения 50 Гц, время испытания 60 с.
R_{isol}	Сопротивление изоляции между беспотенциальным основанием и его выводами, МОм, не менее	50	Нормальные климатические условия. $U_{isol}=1000$ В. Время приложения испытательного напряжения не менее 10 с.
		5	Повышенная влажность (100% при 25°C). $U_{isol}=1000$ В. Время приложения испытательного напряжения не менее 10 с.